

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2021年9月16日(16.09.2021)



(10) 国際公開番号

WO 2021/182277 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/304 (2006.01)

ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(21) 国際出願番号: PCT/JP2021/008368

(22) 国際出願日: 2021年3月4日(04.03.2021)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2020-044714 2020年3月13日(13.03.2020) JP

(71) 出願人: 株式会社フジミインコーポレー
テッド(**FUJIMI INCORPORATED**) [JP/JP];
〒4528502 愛知県清須市西枇杷島町地領
二丁目1番地1 Aichi (JP).

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保
護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS,
MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM,
ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ,
TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ,
DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT,
LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS,
SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM,
GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告(条約第21条(3))

(72) 発明者: 土屋 公亮(**TSUCHIYA, Kohsuke**);
〒4528502 愛知県清須市西枇杷島町地領二丁
目1番地1 株式会社フジミインコーポレー
テッド内 Aichi (JP). 市坪 大輝(**ICHITSUBO,**
Taiki); 〒4528502 愛知県清須市西枇杷島町
地領二丁目1番地1 株式会社フジミイン
コーポレーテッド内 Aichi (JP).

(74) 代理人: 安部 誠(**ABE, Makoto**); 〒4600002 愛
知県名古屋市中区丸の内三丁目20番3
号 B P R プレイス久屋大通 特許業務法
人協働特許事務所 Aichi (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保
護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ,
BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ,
EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN,
HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY,
MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ,
NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT,
QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,

(54) **Title:** POLISHING COMPOSITION AND POLISHING METHOD

(54) 発明の名称: 研磨用組成物および研磨方法

(57) **Abstract:** Provided is a polishing composition that contains a cellulose derivative, said polishing composition exhibiting improved polishing properties and being capable of improving the wettability of a polished silicon wafer surface. The polishing composition contains abrasive grains, the cellulose derivative, a basic compound, and water. The zeta potential of the polishing composition is -24.0 mV or greater.

(57) 要約: セルロース誘導体を含む組成物において、研磨加工性を改善し、かつ研磨後のシリコンウェーハ表面の濡れ性を向上し得る研磨用組成物を提供する。研磨用組成物は、砥粒、セルロース誘導体、塩基性化合物および水を含む。ここで、上記研磨用組成物のゼータ電位は-24.0 mV以上である。



WO 2021/182277 A1